

第三章 静态场

——静电场

- 静电场的基本方程
- 边界条件
- 电位方程
- 静电场中的理想导体
- 电偶极子和电介质
- 静电能量

论述一门学科两种方法

归纳法

演绎法

定义基本量

规定数学运算规则

假设基本关系

3.1 静电场和恒定电流场

3.1.1 两个基本方程

微分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{array} \right.$$

$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

静电场有散无旋

➤ 电场强度的定义： 当一个**试验电荷**置于电场区域时，所受到的单位电荷力。

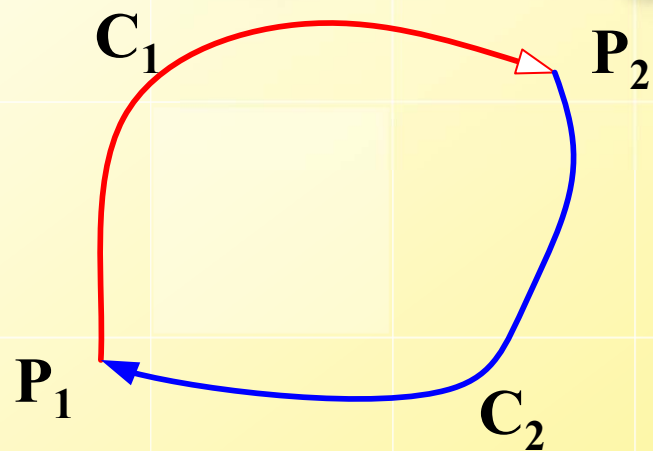
$$\mathbf{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q} \quad (\text{V/m})$$

存在媒质时，引入辅助量——电位移矢量 $\vec{\mathbf{D}} = \varepsilon_0 \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{\mathbf{D}} = \rho \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = 0 \end{array} \right.$$

积分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0} \\ \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \end{array} \right.$$



自由空间静电学的两个基本方程

微分形式	积分形式
$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$
$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$

➤ 几种典型带电体系的E分布

a) 点电荷【例3.2, p38】

➤ 点电荷q在原点

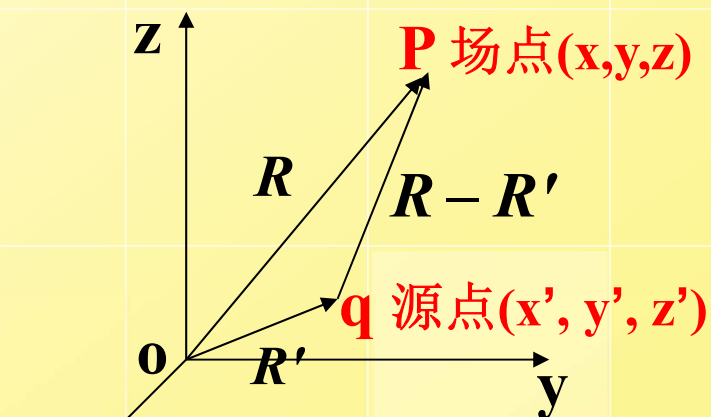
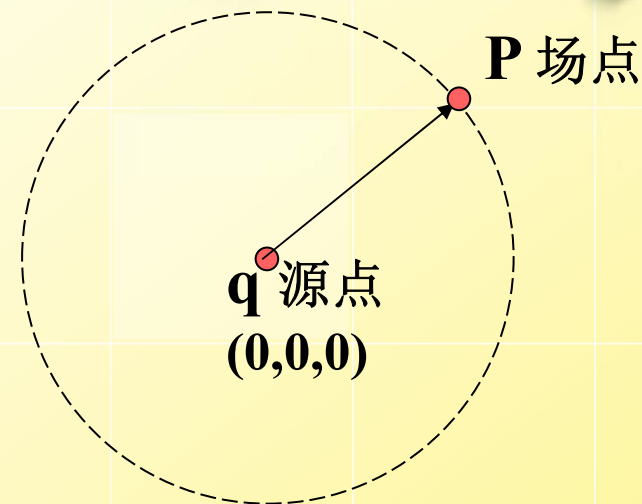
$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\mathbf{a}_R E_R) \cdot \mathbf{a}_R dS = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

➤ 点电荷q不在原点

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_{qp} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2}$$

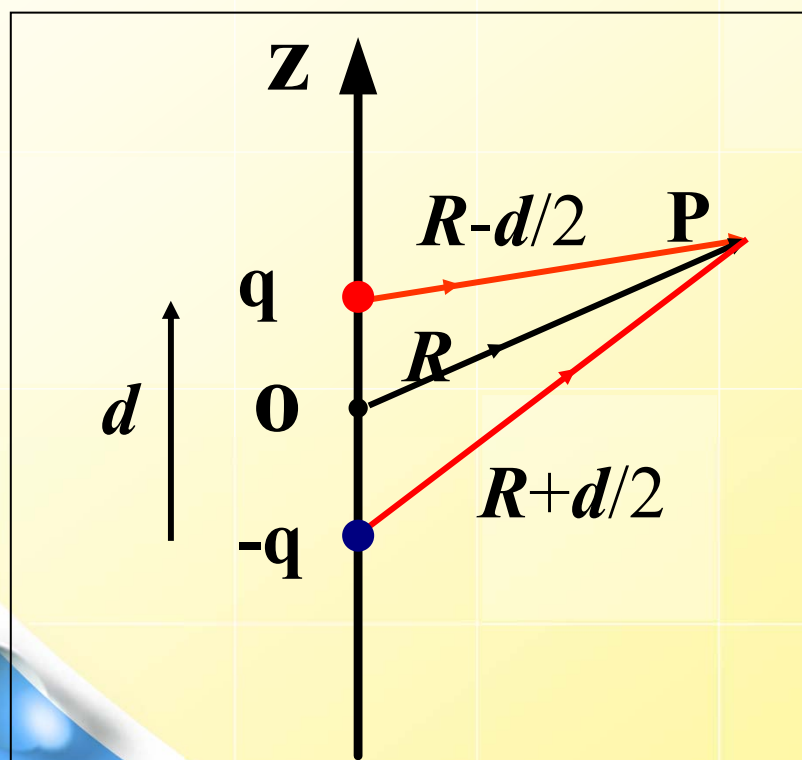
$$\mathbf{E} = \frac{q(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \quad \mathbf{a}_{qp} = \frac{\mathbf{R} - \mathbf{R}'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$



➤ 离散电荷系统

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k (\mathbf{R} - \mathbf{R}_k')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_k'|^3}$$

例：求电偶极子的电场分布



由间距“很小”的两个等量正负“点”电荷组成。

间距： $d \ll R$

点电荷： $+q, -q$

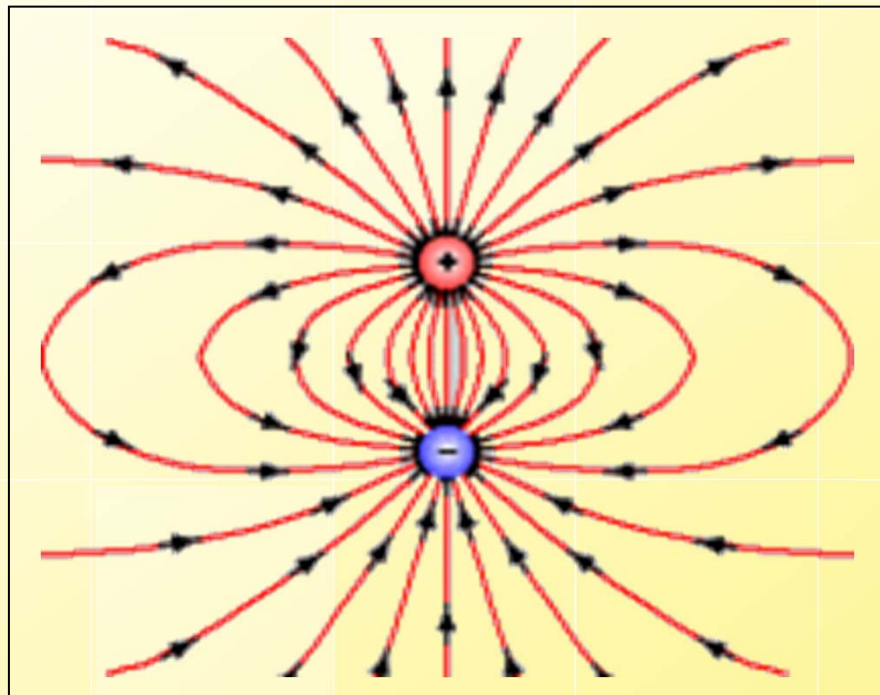
由叠加原理，得：

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left[3 \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \mathbf{R} - \mathbf{d} \right]$$

定义电偶极矩

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 R^3} (2\cos\theta \mathbf{a}_R + \sin\theta \mathbf{a}_\theta)$$

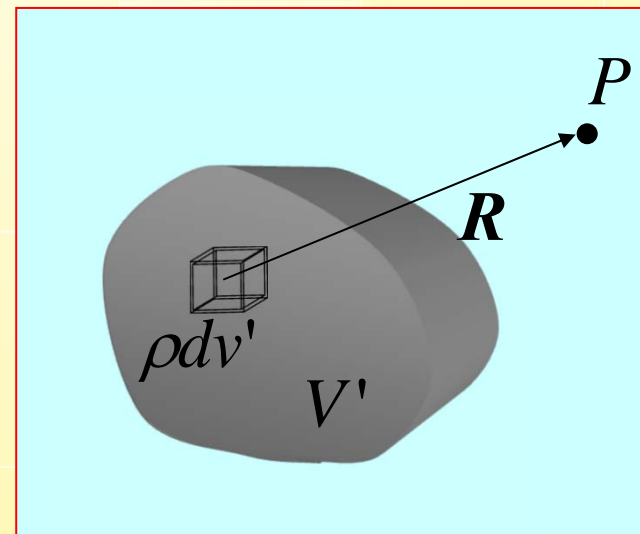


电偶极子的电场分布

➤ 连续分布电荷系统

$$d\mathbf{E} = \mathbf{a}_R \frac{\rho dv'}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \mathbf{a}_R \frac{\rho}{R^2} dv'$$
$$\left(\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \rho \frac{\mathbf{R}}{R^3} dv' \right)$$

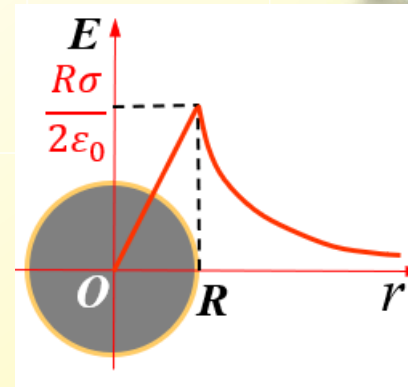


$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \mathbf{a}_R \frac{\rho_s}{R^2} ds' \quad (\text{面电荷分布})$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \mathbf{a}_R \frac{\rho_l}{R^2} dl' \quad (\text{线电荷分布})$$

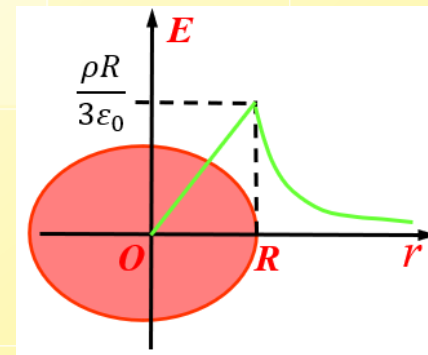
b) 无限长直线电荷 【例3.1】 $\vec{E} = \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{a}_r$

c) 长直圆柱带电体 $\vec{E} = \begin{cases} \frac{R^2 \rho}{2\epsilon_0 r} \hat{a}_r & (r \geq R) \\ \frac{r \rho}{2\epsilon_0} \hat{a}_r & (r < R) \end{cases}$

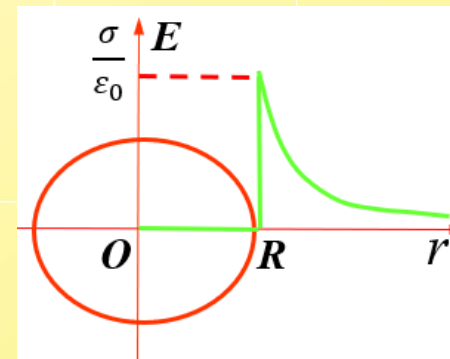


d) 无限大均匀面电荷 $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{a}_n$, 外法向

e) 均匀带电球体 $\vec{E} = \begin{cases} \frac{qr \hat{a}_r}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r \leq R) \\ \frac{q \hat{a}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r \geq R) \end{cases}$

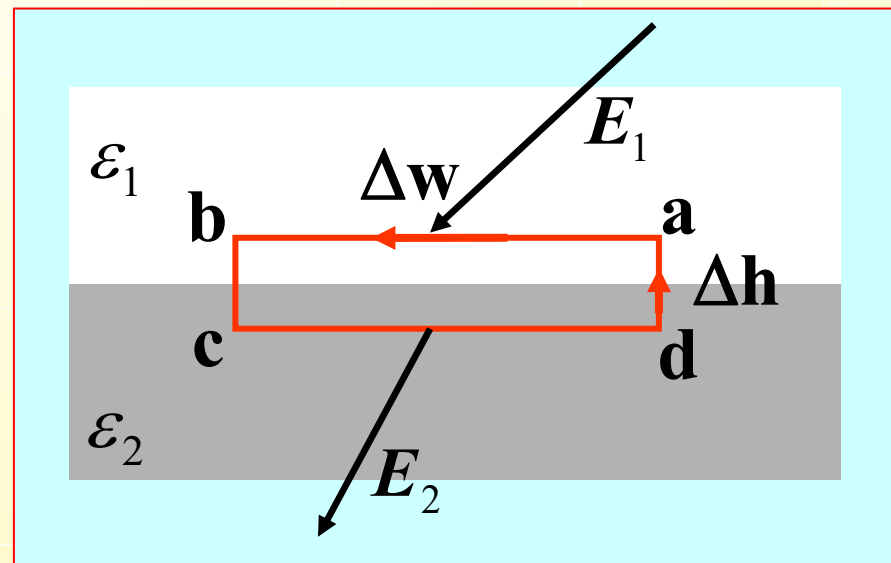


f) 均匀带电球面 $\vec{E} = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q \hat{a}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$



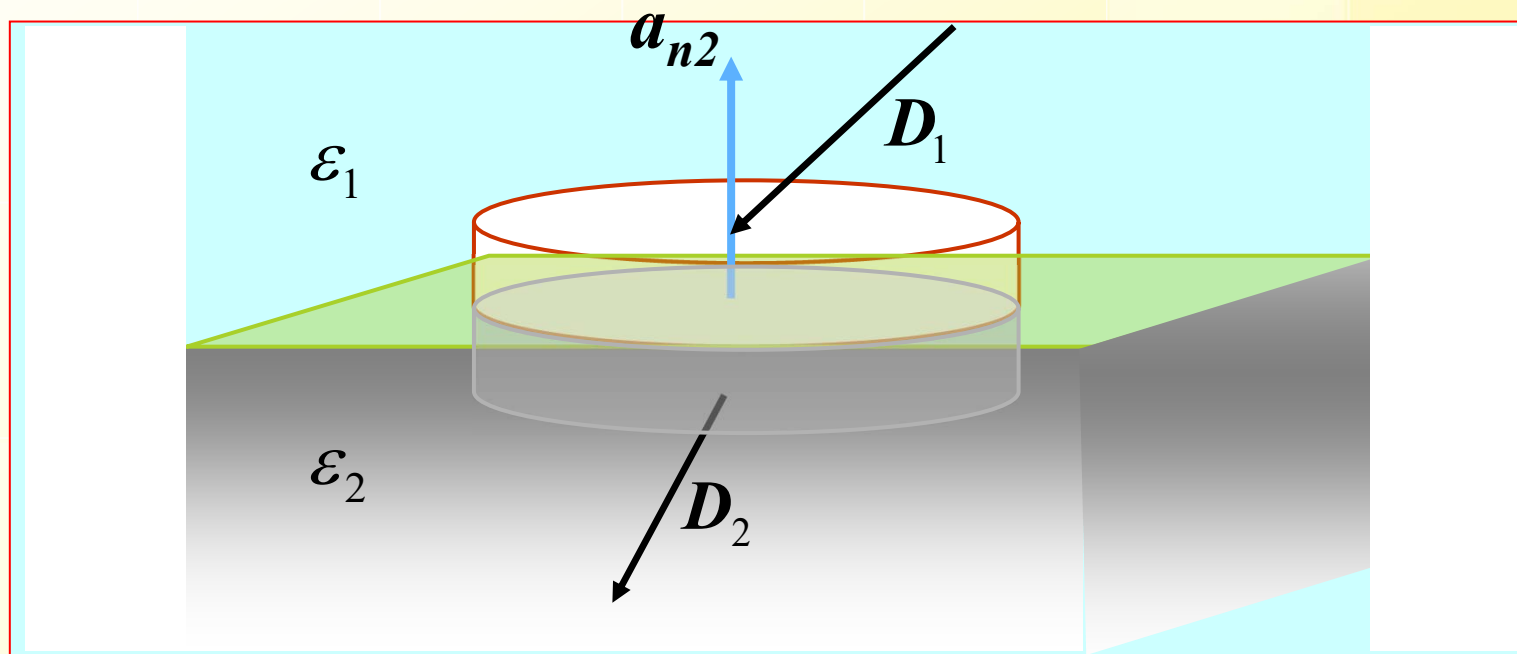
3.1.2 静电场边界条件

► 切向边界条件



$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \longrightarrow \quad E_{1t} = E_{2t}$$

➤ 法向边界条件

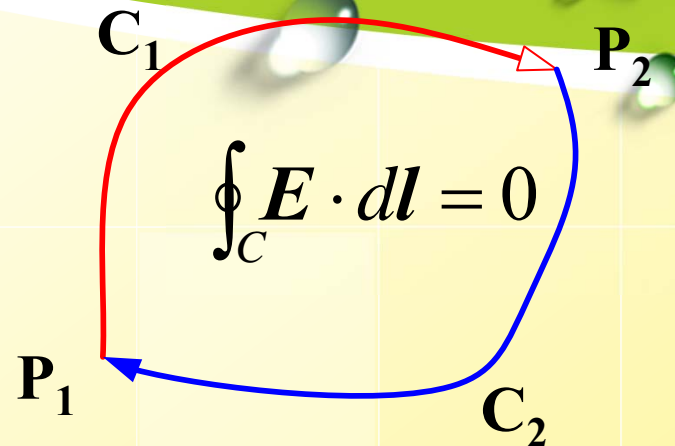


$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \quad \longrightarrow \quad \mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s$$
$$D_{2n} - D_{1n} = \rho_s$$

3.1.3 电位方程 $E = -\nabla V$

任何做功与路径无关的力场，
叫做保守力场，或位场（势场）

定义： $V_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$



【讨论】：

- 1、电势 U_a 等于单位正电荷自 a 点移至 ∞ 远电场力作的功，
或等于单位正电荷自 ∞ 远移至 a 点外力的功；
- 2、电势是标量，但是有正、有负；
- 3、原则上，零电势点是可任选的；
理论上，一般取 ∞ 远处电势为零（限有限尺寸的带电体）
实际中，一般选大地为零；
- 4、电势差（电压）： $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$
- 5、电场力的功： $A_{ab} = q(V_a - V_b)$

a) 典型分布电荷的电位

➤ 点电荷

$$V = - \int_{\infty}^R \mathbf{a}_R \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \right) \cdot (\mathbf{a}_R dR)$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (\text{V})$$

➤ 离散点电荷系统

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_k|}$$



思考

电偶极子的电场强度 $V \longrightarrow E = -\nabla V$

【例】：求电偶极子电位与电场的分布

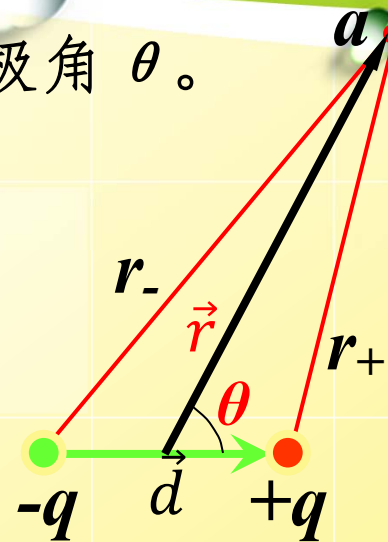
【解】：设电偶极子 $\vec{P} = q\vec{d}$ ，任一点a距离中心 r ，极角 θ 。

则电势

$$V = V_+ + V_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

由图有：

$$r_+ \approx r - \frac{d}{2} \cos\theta, \quad r_- \approx r + \frac{d}{2} \cos\theta, \quad \frac{1}{r_1 r_2} = \frac{1}{r^2}$$



电偶极子的电场

代入上式得

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{d\cos\theta}{r^2 - (\frac{d}{2}\cos\theta)^2} \approx \frac{qd\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{P} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

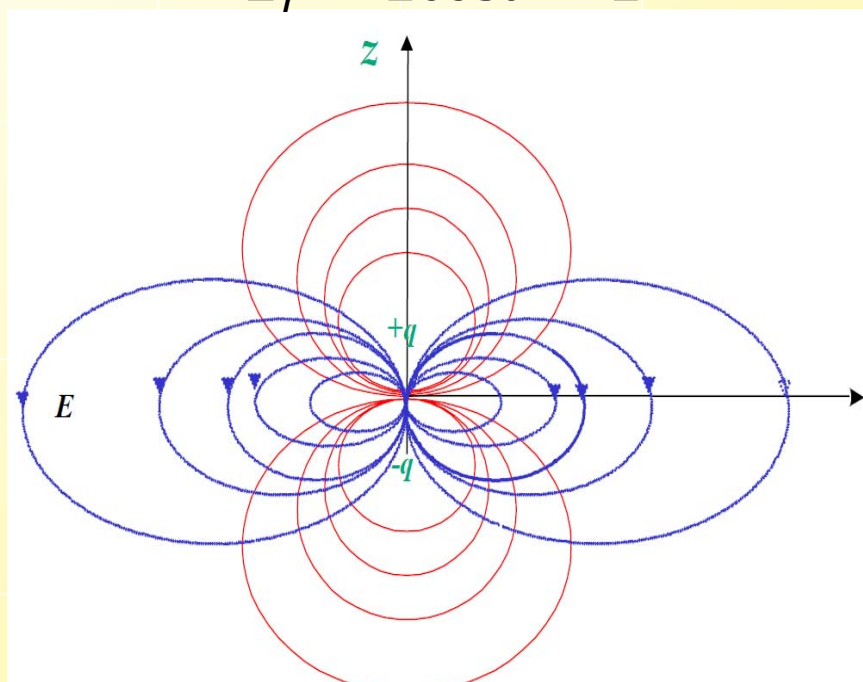
电场强度

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{P \cos \theta}{2\pi \epsilon_0 r^3}, \quad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{P \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 r^3}, \quad E_\varphi = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \varphi} = 0$$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{P}{4\pi \epsilon_0 r^3} \sqrt{3 \cos^2 \theta + 1}$$

$$\vec{E} \text{ 与 } \vec{r} \text{ 夹角 } \alpha \quad \tan \alpha = \frac{E_\theta}{E_r} = \frac{\sin \theta}{2 \cos \theta} = \frac{1}{2} \tan \theta$$

$$\begin{aligned} \theta = 90^\circ &\rightarrow \alpha = 90^\circ \\ \theta = 0^\circ &\rightarrow \alpha = 0^\circ \end{aligned}$$

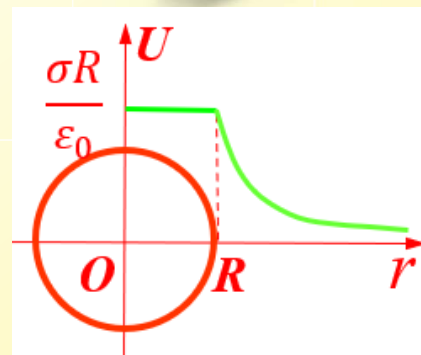


电偶极子等位线和电场线

➤ 均匀带电球面内外的电位：

球外 ($r > R$) : $V_1 = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

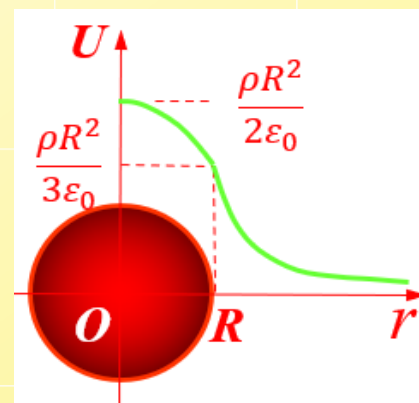
球内 ($r \leq R$) :
$$V_2 = \int_r^R \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_R^\infty \vec{E}_1 \cdot d\vec{l}$$
$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0}$$



➤ 均匀带电球体内外的电位：

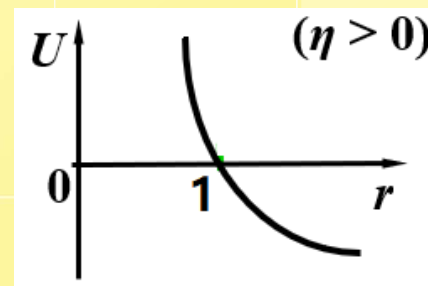
球外 ($r > R$) : $V_1 = \int_r^\infty \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

球内 ($r \leq R$) : $V_2 = \int_r^R \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_R^\infty \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$



➤ 均匀长直线电荷的电势 ($r=1$ 零点)

$$V = \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{r}$$



➤ 思考：无限大平板（或均匀电场）的电位分布？

➤ 离散点电荷系统

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_k'|}$$

➤ 连续分布电荷系统

体电荷分布

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{v'} \frac{\rho}{R} dv'$$

面电荷分布

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{s'} \frac{\rho_s}{R} ds'$$

线电荷分布

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \frac{\rho_l}{R} dl'$$

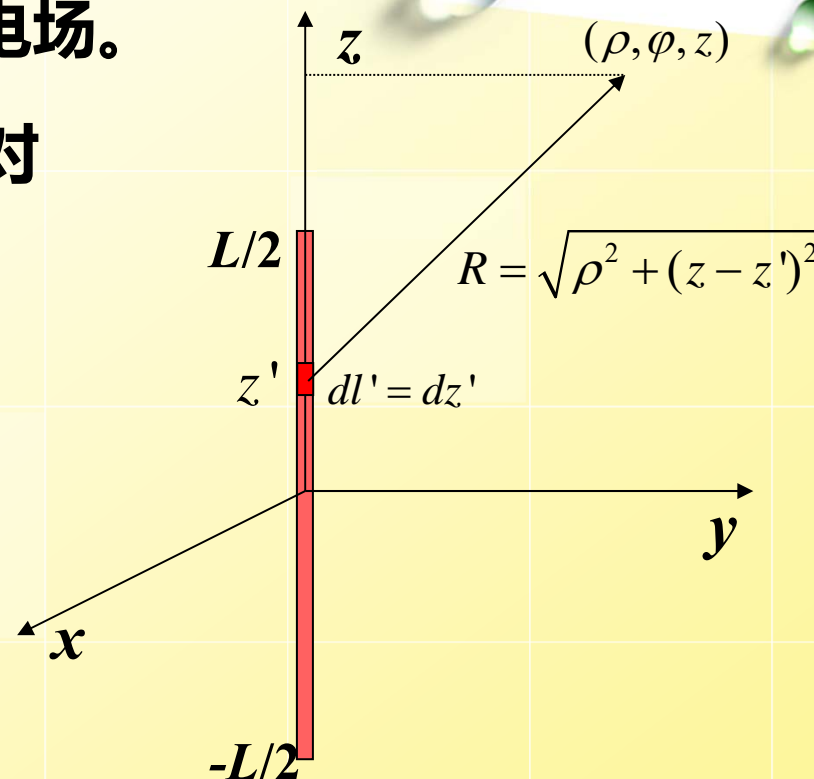
例：求长度为 L ，电荷线密度为 η 的长直均匀带电线的电位及电场。

解：建立圆柱坐标系，使具有轴对称性的场与 φ 无关。

计算线电荷上位置 z' 的微元 dl' 在场点 (ρ, φ, z) 的电位

$$\begin{aligned}d\Phi &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\eta dl'}{R} \\&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\eta dz'}{\sqrt{\rho^2 + (z - z')^2}}\end{aligned}$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{\eta}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{\sqrt{\rho^2 + (z - z')^2}} = \frac{\eta}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{z + \frac{L}{2} + \sqrt{\rho^2 + (z + \frac{L}{2})^2}}{z - \frac{L}{2} + \sqrt{\rho^2 + (z - \frac{L}{2})^2}}$$



$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\Phi = -(\hat{\rho}\frac{\partial\Phi}{\partial\rho} + \hat{\phi}\frac{1}{\rho}\frac{\partial\Phi}{\partial\phi} + \hat{z}\frac{\partial\Phi}{\partial z})$$

$$= \frac{\eta}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \hat{\rho} \frac{1}{\rho} \left(\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{\rho^2 + (z + \frac{L}{2})^2}} - \frac{z - \frac{L}{2}}{\sqrt{\rho^2 + (z - \frac{L}{2})^2}} \right) \right. \\ \left. + \hat{z} \left(\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z + \frac{L}{2})^2}} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z - \frac{L}{2})^2}} \right) \right\}$$

$$L \rightarrow \infty \quad \vec{E} = \hat{\rho} \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0\rho}$$

3.1.3 电位方程

电位方程

➤ 泊松方程

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

➤ 拉普拉斯方程

在没有自由电荷存在的区域:

$$\nabla^2 V = 0$$

满足给定边界条件的泊松方程(拉普拉斯方程)的解是唯一的解。

➤ 思考: 电位的边界条件是什么?

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

柱面坐标

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

球面坐标

$$\nabla^2 V = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial V}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}$$

【例】 半径为 a 的导体球电位为 U （无穷远处电位为0），求球外的电位函数。

【解】 思路：由 E 求 U ？

在球外： $\rho = 0$ ， φ 满足拉普拉斯方程 $\nabla^2 \varphi = 0$

边界条件： $\varphi|_{r=a} = U$ $\varphi|_{r \rightarrow \infty} = 0$ （无穷远为电位参考点）

导体球电位球面对称： $\varphi = \varphi(r)$

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right) = 0, \Rightarrow r^2 \frac{d\varphi}{dr} = C_1 \rightarrow \varphi = -\frac{C_1}{r} + C_2$$

由边界条件：

$$\left. \begin{array}{l} \varphi|_{r=a} = U \Rightarrow U = -\frac{C_1}{a}, C_1 = -aU \\ \varphi|_{r \rightarrow \infty} = 0 \Rightarrow C_2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \varphi = \frac{aU}{r}$$

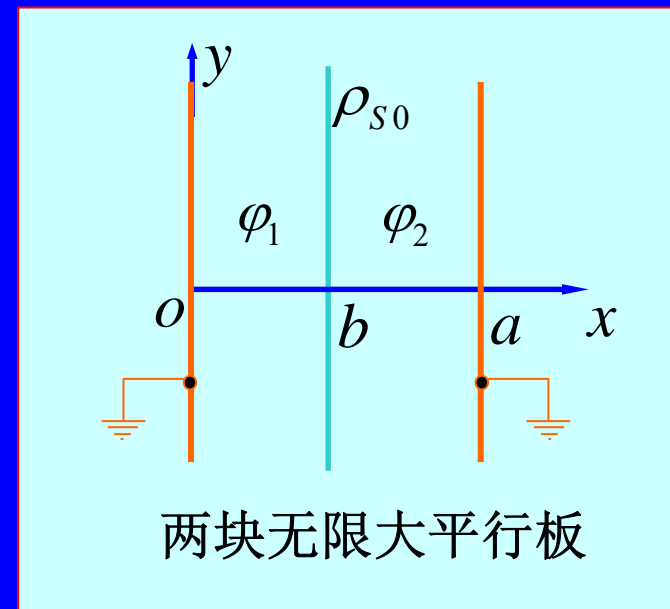
例： 两块无限大接地导体平板分别置于 $x=0$ 和 $x=a$ 处，在两板之间的 $x=b$ 处有一面密度为 ρ_{s0} 的均匀电荷分布，如图所示。求两导体平板之间的电位和电场。

分析 $\varphi_1 = \varphi_1(x), \quad \varphi_2 = \varphi_2(x)$

解 $\frac{d^2 \varphi_1(x)}{dx^2} = 0, \quad (0 < x < b)$

$$\frac{d^2 \varphi_2(x)}{dx^2} = 0, \quad (b < x < a)$$

方程的解为 $\varphi_1(x) = C_1 x + D_1$
 $\varphi_2(x) = C_2 x + D_2$



确定待定常数

方法

$$x=0 \text{ 处}, \varphi_1(0)=0$$

$$x=a \text{ 处}, \varphi_2(a)=0$$

$$x=b \text{ 处}, \varphi_1(b)=\varphi_2(b), \quad \longrightarrow$$

$$\left[\frac{\partial \varphi_2(x)}{\partial x} - \frac{\partial \varphi_1(x)}{\partial x} \right]_{x=b} = -\frac{\rho_{s0}}{\varepsilon_0}$$

$$C_1 = -\frac{\rho_{s0}(b-a)}{\varepsilon_0 a}, \quad D_1 = 0$$

$$C_2 = -\frac{\rho_{s0}b}{\varepsilon_0 a}, \quad D_2 = \frac{\rho_{s0}b}{\varepsilon_0}$$

利用边界条件

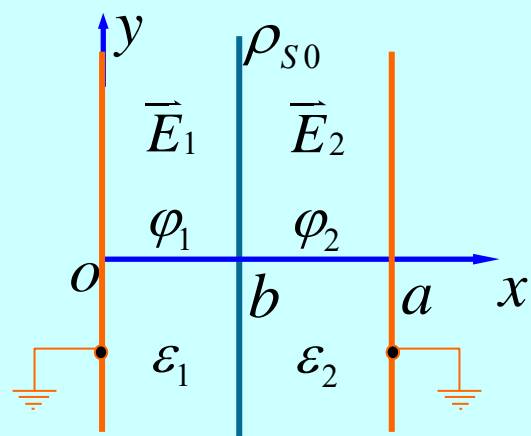
最后得

$$\varphi_1(x) = \frac{\rho_{s0}(a-b)}{\varepsilon_0 a} x, \quad (0 \leq x \leq b) \quad \vec{E}_1(x) = -\nabla \varphi_1(x) = -\vec{e}_x \frac{\rho_{s0}(a-b)}{\varepsilon_0 a}$$

$$\varphi_2(x) = \frac{\rho_{s0}b}{\varepsilon_0 a} (a-x), \quad (b \leq x \leq a) \quad \vec{E}_2(x) = -\nabla \varphi_2(x) = \vec{e}_x \frac{\rho_{s0}b}{\varepsilon_0 a}$$

延伸应用思考：

- 用直接积分的方法如何求解？
- 用高斯定理求解？
- 两区的介质不同？
- 其它坐标系下的同类问题？



两块无限大平行板

3.1.4 静电场中的理想导体

1) 媒质的分类

导电媒质



导体

理想电介质



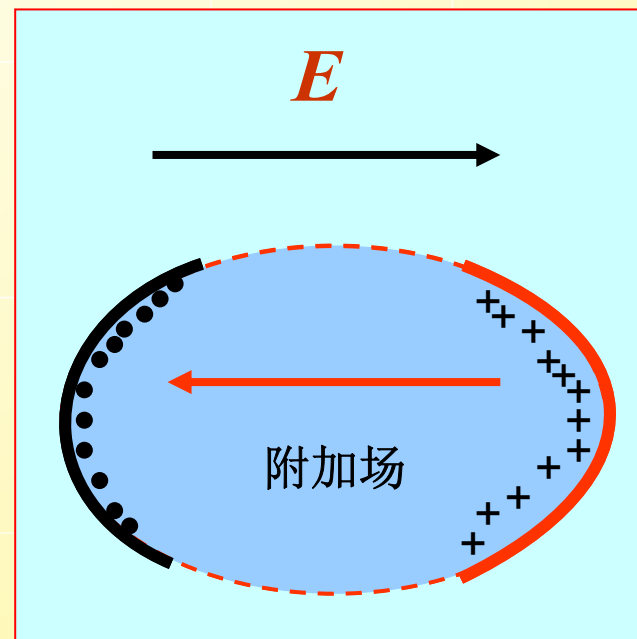
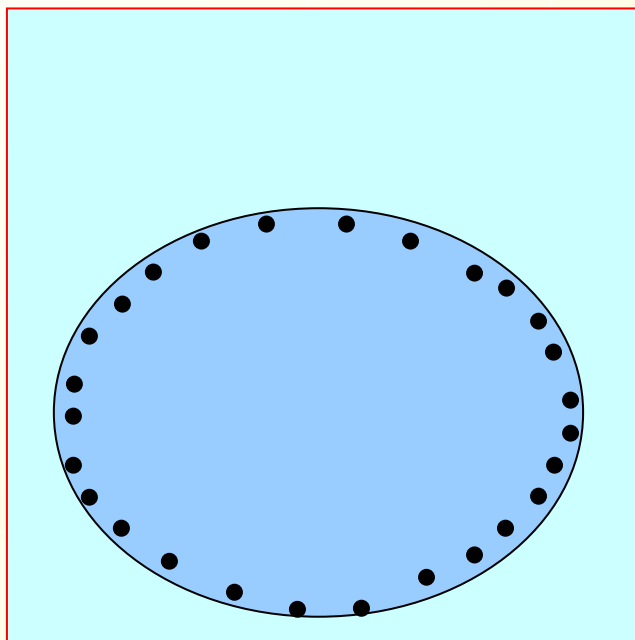
绝缘体

半导电媒质



半导体

2) 静电场中的导体

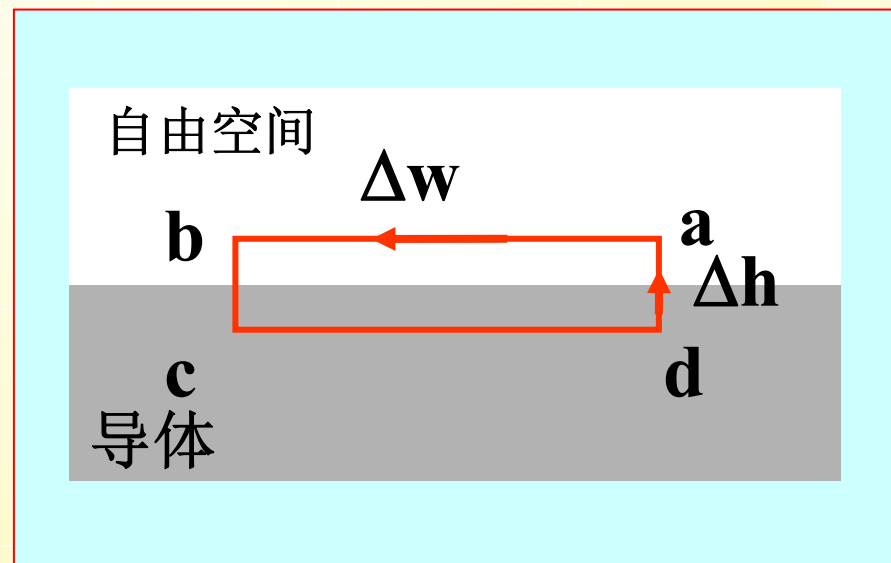


静电平衡

导体内部没有电流、没有自由电荷、电场为零
导体为等位体
导体表面为等位面
自由电荷集聚在表面，形成面电荷分布

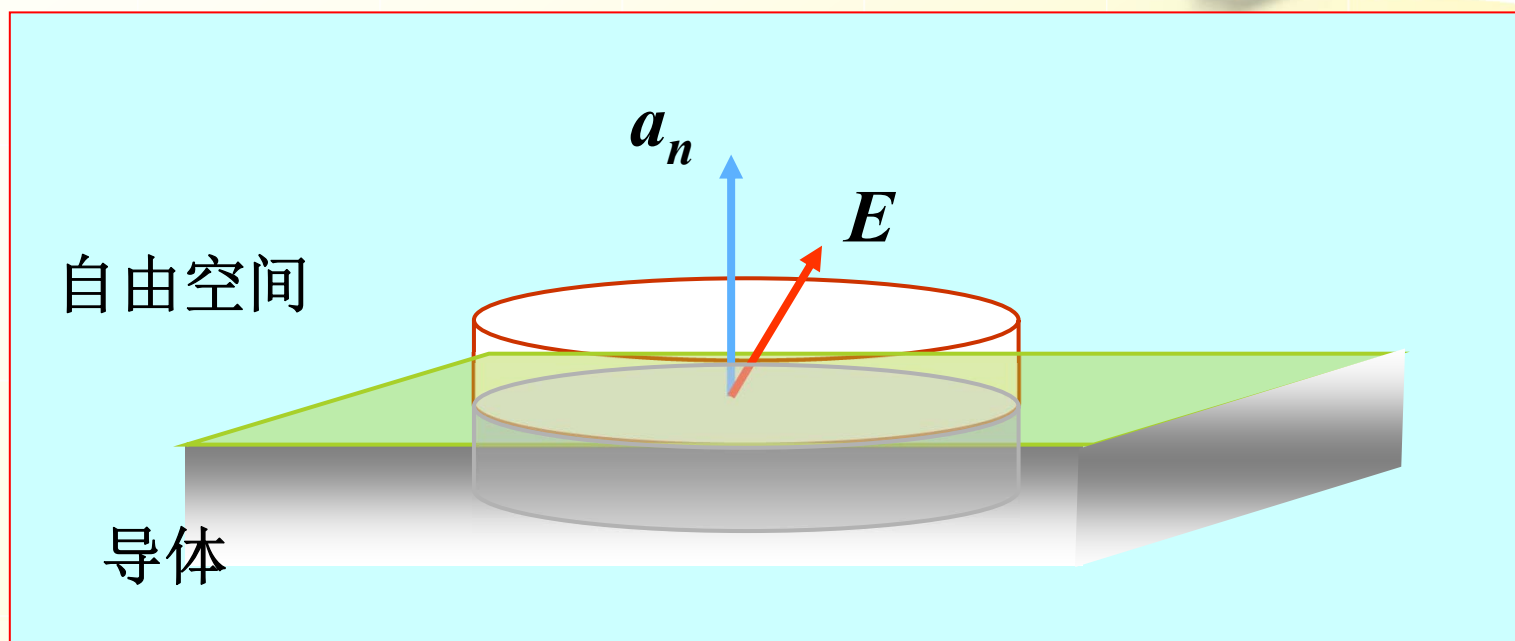
导体与自由空间的边界条件

► 切向边界条件



$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \longrightarrow \quad E_t = 0$$

➤ 法向边界条件



$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0} \implies E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

导体-自由空间的边界条件

$E_t = 0$	$E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$
-----------	-----------------------------------

➤ 思考：导体-自由空间边界的电位法向条件是什么？